SOLUBLE SILICONE-IMIDE POLYMER

Patent number:

JP61118424

Publication date:

1986-06-05

Inventor:

CHIYAN JIEN RII

Applicant:

GEN ELECTRIC

Classification:

- international:

C08G73/10; C08G77/42; C08L79/08

- european:

Application number: JP19850231489 19851018 Priority number(s): US19840662930 19841019

Abstract not available for JP61118424 Abstract of correspondent: US4586997

There is provided a siloxane-imide copolymer composition having at least one polymeric block with a low glass transition temperature and at least one polymeric block with a high glass transition temperature. Preferred compositions have the general formula +TR

図 US45869

$$\left\{
\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}
\right\} Y - A_{1} - Y - \left(
\begin{array}{c}
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{array}
\right\} N - R^{2}$$

昭61-118424 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int_Cl_4 C 08 G 73/10 77/42

庁内整理番号 識別記号 101

43公開 昭和61年(1986)6月5日

C 08 L 79/08

審査請求 未請求 発明の数 6

可溶性シリコーンーイミドコポリマー の発明の名称

> 願 昭60-231489 ②特

願 昭60(1985)10月18日 22出

優先権主張 到1984年10月19日 到米国(US) 到662930

切発 明 者 チャン・ジェン・リー アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、バルストン・レイク、 バーニング・ブツシユ・ブルーバード、14番

アメリカ合衆国、12305、ニユーヨーク州、スケネクタデ ⑪出 頣 ゼネラル・エレクトリ

イ、リバーロード、1番 ツク・カンパニイ 邳代 理 人 弁理士 生沼 徳二

/ 発明の名称

可密性シリコーン・イミドコポリマー

2 特許請求の範囲

(1) ガラス転移温度が低いポリマーブロック少 なくとも!つとガラス転移温度が高いポリマーブ ロック少なくとも!つとを有するシロキサン・イ ミドコポリマー組成物。

(2) ガラス転移温度が低い少なくとも/つのポ リマーブロックが式:

$$\begin{pmatrix}
O & O \\
\parallel & \parallel \\
C & C \\
N & Ar & N-R \\
C & C \\
\parallel & \parallel \\
O & O
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R^{1} \\
\downarrow \\
SiO \\
R^{1} \\
n & R^{1}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R^{1} \\
\downarrow \\
R^{1} \\
n & R^{1}
\end{pmatrix}$$

〔式中、 Ar は四価の芳香族基であり、 Rは健換 もしくは非世換のヒドロカルピレン基または式:

$$-Q-Z-R^{4}-$$

(式中、Qは置換または非世換の芳香族基であり、

но OH り、 R³ は世換または非世換のヒドロカルビレン である)の基であり、各 R はそれぞれ独立に選 択された置換または非置換のヒドロカルビル基で あり、πは/に等しいかまたはこれより大きい整 数である〕を有することを特徴とする特許請求の 範囲第/項に記載の組成物。

(3) ガラス転移温度が高い少なくとも/つのポ リマーブロックが式:

特開昭61-118424 (2)

〔式中、 Ar は二価の芳香族基であり、 R は

(式中、 R⁴ は炭素原子を/~9個有するアルキル基であり、 R⁵ は炭素原子を/~4個有するアルキレン基である)から成る群から選択された基であり、Yは酸素またはイオウである]を有することを特徴とする特許請求の範囲第/項または第2項に記載の組成物。

(4) 一般式:

(式中、 R^5 は炭素原子を $/\sim 9$ 個有するアルキル基であり、 R^5 は炭素原子を $/\sim 4$ 個有するアルキ

$$\left\{ \begin{array}{c|c} O & O \\ II & II \\ C & C \\ N & Ar & N-R \\ \hline C & C \\ II & II \\ O & O \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ SIO \\ R^{1} \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ R^{1} \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \end{array} \right. \left. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I \\ I \end{array} \right. \left. \begin{array}{c} R^{1} \\ I$$

〔式中、各 Ar はそれぞれ独立に選択された芳香 族基であり、Rは置換もしくは非世換のヒドロカ ルピレン基または式:

$$-Q-Z-R^{3}-$$

(式中、Qは置換または非道換の芳香族基であり、 Zは

レン基である)から成る群から選択された基であり、Yは酸素またはイオウであり、 a, b, c および n は全て / に等しいかまたはこれより大きい整数である)を有するジグライム可飛性シロキサン・イミドコポリマー組成物。

(5) 少なくとも / 個の Ar がペンゼン核、ナフタレン核または式:

$$(E)_{\overline{m}}$$

〔式中、mは0または/であり、Eは-0-,

ただし、yは/~よの整数である)である]の核 を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項 に記載の組成物。

(6) 少なくとも/個の Ar が式:

〔式中、Gはフェニレンまたは式:

{式中、mは0または/であり、Eは-0-.

ただし、yは/〜よの整数である)である)の基である)を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項に記載の組成物。

(7) 少なくとも/個の Ar 基が式:

とする特許請求の範囲第8項に記載の組成物。

- 0.3 感光性の基を少なくとも/つ含有すること を特徴とする特許請求の範囲第8項に記載の組成 物。
- (14) 前配感光性の基がアクリレート類、シンナメート類、2。3-ジフェニルシクロプロペノールエステル類またはこれらの混合物であることを特徴とする特許請求の範囲第 /3 項に配載の組成物。
- (5) (A) 遊当な路媒中で、
- (i)有機二無水物を、ジアミノで末端停止したポリシロキサンと、および
- (肌)有機二無水物を有機ジアミンと、反応させ、
- (B) (A)(i)の反応生成物を(A)(ii)の 反応生成物と混合し、これらを反応させ、
- (C) (B)の反応生成物を加熱してイミド化することからなる、ガラス転移温度が低いポリマーブロックを少なくとも/つとガラス転移温度が高いポリマーブロックを少なくとも/つ有するシロキサン・イミドコポリマー組成物の製造方法。
 - (16) さらに、反応密鉄を蒸発させることを含む

を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項 に記載の組成物。

- (8) Rが低級アルキレン基であることを特徴とする特許請求の範囲第4項、第5項または第6項のいずれかに記載の組成物。
- (9) R¹ がメチル、エチル、プロピル、ブチル、フェニル、ピニルおよび 3,3,3-トリフルオロプロピル基からそれぞれ独立に選択されることを特徴とする特許額次の範囲部 8 項に配載の組成物。
- (0) nがよ~/00 の整数であることを特徴とする特許請求の範囲角を項に記載の組成物。
- (I) Yが酸素であることを特徴とする特許請求 の範囲第8項に配載の組成物。
- R^4 が炭素原子を $/\sim 3$ 個有しており、 R^5 が炭素原子を/または2 個有していることを特徴

ことを特徴とする特許請求の範囲第 /5 項に記載 の方法。

- (17) さらに、無溶鉄組成物をジグライムに溶解させることを含むことを特徴とする特許請求の範囲第 / 6 項に配載の方法。
- 18 (A) 適当な溶族中で、
- (1)有機二無水物、有機ジアミン、およびジアミンで末端停止したポリシロキサン(ただし、有機 二無水物のモル量は有機ジアミンとジアミノで末 端停止したポリシロキサンのモル量の和にほぼ等 しい)を反応させ、
- (B) 反応生成物を加熱してイミド化することからなる、ガラス転移温度が低いポリマーブロックを少なくとも1つとガラス転移温度が高いポリマーブロックを少なくとも1つ有するシロキサン・イミドコポリマー組成物の製造方法。
- 四 さらに、反応容談を蒸発させることを含む ことを特徴とする特許請求の範囲第 / 8 項に記載 の方法。
 - ② さらに、無俗媒組成物をジグライムに溶解

させることを含むことを特徴とする特許例求の短 囲第 19 項に記録の方法。

② 基体上に、特許耐水の短囲窓/項、窓2項、第3項または第4項に配送の組成物を有する物品。

四 基体がほ子デバイスであることを特徴とする特許的求の範囲第 2/ 項に配徴の物品。

四 特許別求の短囲第ノ項、第2項、第3項または餌火項に記憶の俎成物を基体に設布することからなる物品の組造方法。

24 俎成物を将鉄中で込布することを特徴とする特許額次の箆囲館 23 項に配送の方法。

四 加口して番曲を蒸発させることを特徴とする特許的水の短囲は 24 項に記録の方法。

3. 発明の停細な説明

発明の背景

本発明はシロキサン草位とイミド草位の両者を有するポリマー組成物に係る。 さらに特定すると本発明はジグライム(すなわちジグリコールメチルエーテル領)に可容なシロキサン・イミドコポリマーに係る。

性の高い容典に可格であり、この形態で末端ユーザーに供給されている。

典型的な場合、末端ユーザーがポリアミド酸のコーティングを基体上に直布した扱的/50℃~ 約400℃の温度に加燥して唇做を除去しかつ現化 を起こさせてたとえば次式(II)を有するシロキサ ン・イミドコポリマーを形成することによつて、 シロキサン・イミドポリマーが作られる。

$$\begin{pmatrix}
0 & & & & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & \\
0 & & & & \\$$

たとえばジアミノシロキサンと、ベンゾフェノン二無水物のような二無水物とを反応させて次式(!)を有するポリアミド酸を得ることによつてシロキサン・イミドコポリマーを製造できることは类界で公知である。

$$\begin{array}{c|c}
 & R' \\
 & SiO \\
 & SiO \\
 & R' \\
 & R' \\
 & R' \\
 & R' \\
 & R \\
 & R'$$

ここで、Rは二価の炭化水炭基であり、R'は一価の炭化水泵基であり、mは/より大きい盛飲であり、nは/Oより大きい盛飲である。 これらのポリアミド酸はN-メチルピロリドンのような板

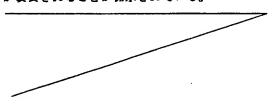
これらのポリイミドは、半辺体その他の位子デバイスの保護コーティングとして有用ではあるが、普通の有機酸のほとんどに不容であるという欠陥を有している。 このポリアミド配を/50℃ ~400℃の温度に加強する必要があるというこの方法の別の欠点は、多くの半辺体テバイスような高温に加強することができないというかに、このような高温に加強することができないが、そことである。 さらに、このアミド酸は加水分解に、ゴス完全なイミド化を妨げることになる、カルボン、で全なイミド化を妨げることになる、カルボン、は登を形成し得るということが当気者には理がよれよう。 したがつて、アミド酸の形態ではなんことが認まれる。

ホルブ (Holub) の米国特许*第3.325.450*号には、上記の式 (II) のポリイミド - シロキサンと、ジアミノシロキサンと有极二無水物を反応させてポリアミド酸を形成し、その後このポリアミド酸を加強してイミド化させることによるその製法と

が開示されている。 ホルブ (Holub)の数示の変形は米国特許第3392/44号、第3435,002号、第3553282号、第355874/号、第3663728号および第3740305号にみることができる。

パージャー(Berger)の米国特許第4030 948号には、テトラカルポン酸二無水物、有機 ジアミンおよびジ(アミノアルキル)ポリシロキ サンの反応生成物であるポリイミドコポリマーが 開示されている。 ここでジ(アミノアルキル) ポリシロキサンはポリマーの全アミン必要量の /8 ~ 45 モル多を構成している。

パージャー(Berger)の米路特許第5395, 527号には、 次式のシロキサン単位を含有する ポリイミドによつてポリイミドの将解性と接着性 が改良されることが闘示されている。



ぞれ独立して0~100の値を有する。 - 12 K このようなポリイミドは、 N. N -ジメチルアセト アミド、N-メチルカプロラクタム、ジメチルス ルホキシド、N-メチル・ユーピロリドン、テト ラメチル泉煮、ピリジン、ジメチルスルホン、ヘ キサメチルホスホアミド、テトラメチレンスルホ ン、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、ブ チロラクトンおよびN-アセチル-2-ピロリド ンのような複性溶媒の他に、ジクロロベンゼンお よびトリクロロベンゼンのような塩素化炭化水素 俗族に可俗であるとされている。 さらにパージ ャー(Berger)の数示するところでは、出発物の / つとしてジェーテル含有紙水物を使用すると、 得られるポリイミドは上配の塩素化炭化水素器鉄 と極性格様ばかりでなく、これがシロキサン単位 を含有する場合、ポリイミドはエチレングリコー ルおよび縮合したポリエチレングリコール類のモ ノアルキルおよび/またはジアルキルエーテル類 および/またはよ員以上の環を含有する環状エー テル類から誘導される裕雄、たと之ばジグライム

$$Q - Z - D - Si \begin{pmatrix} R^{2} \\ i \\ OSi \\ R^{4} \end{pmatrix}_{x} \begin{pmatrix} R^{2} \\ i \\ OSi \\ R^{2} \end{pmatrix}_{x} \begin{pmatrix} R^{5} \\ i \\ OSi \\ R^{4} \end{pmatrix}_{y} \begin{pmatrix} R^{5} \\ i \\ OSi \\ R^{4} \end{pmatrix}_{z}$$

ここで、Qは置換または非置換の芳香族基であり、

-0-C-; であり、Dは非世換または置換の ヒドロカルビレンであり、 R^1 ・ R^2 ・ R^3 ・ R^4 ・ R^5 お よび R^6 はそれぞれ独立して非置換または置換の ヒドロカルビル基であり、x・yおよび z はそれ

にも可容である。 しかし、バージャー(Berger)はポリイミドのジグライムに対する容解度には限界があることを明らかにしている。 バージャー(Berger)によるとジグライムに可容なイミドーシロキサンポリマーを得たければ普通には使用しない、したがつてかなり高価なモノマーを用いる必要があることが当業者には認識されるであろう。別の一面でバージャー(Berger)が当業界に教示しているのは、シロキサン単位を含有するポリイミドが従来のポリイミドのガラス転移温度(Tg)の350℃に比べてずつと低い、たとえば/40℃程度のTg を有しているということである。 したがつてこれらは従来技術のポリイミドより容易に溶験流動するであろう。

発明の概要

本発明の1つの目的は、通常使用しない高価な材料から製造するのではない、ジグライムに可溶なシロキサン・イミドコポリマーを提供することである。

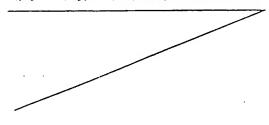
本発明の別の目的は、従来技術のシロキサン

- イミドコポリマーや有機イミドポリマーより広い有用な加工処理範囲を有する組成物を得るべく 2つのガラス転移温度をもつシロキサン・イミドコポリマーを提供することである。

その他の目的と利点は以下の本発明の説明と 添付の特許請求の範囲の配数から当業者には明ら かであろう。

本発明はその最も広い面において、ガラス転 移温度が低いポリマーブロックを少なくとも!つ とガラス転移温度が高いポリマーブロックを少な くとも!つ有するジグライム可裕性シロキサン・ イミドコポリマーからなる。

このジグライム可容性のシロキサン・イミド コポリマーは次の一般式を有するのが好ましい。



であり、 R^3 は置換または非置換のヒドロカルビレンである。 また上記式中、各 R^1 はそれぞれ独立に選択された置換または非置換のヒドロカルビル基であり、 R^2 は

(ただし、 R は炭素原子をノータ個有するアル

$$\begin{pmatrix}
0 & & & & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & & & \\
N & & & & & & & & & & \\
N & & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & & \\
0 & & & & & & & & & \\
\end{pmatrix}$$

ここで、各 Ar はそれぞれ独立して選択された芳香族基であり、Rは置換もしくは非置換のヒドロカルビレン基または次式の基である。

$$-Q - Z - R^5 - .$$

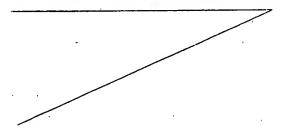
ただし、Qは置換または非置換の芳香族基であり、 2は

キル基であり、 R⁵ は炭素原子を/〜 4 個有する アルキレン基である)から成る群から選択された 基であり、 Y は酸素またはイオウであり、 a . b . c および n は全て / に等しいかまたはそれ以上の 整数である。

発明の説明

本発明によつて、低いガラス転移温度(Tgi)のポリマーブロックを少なくとも1つと高いガラス転移温度(Tg2)のポリマーブロックを少なくとも1つとを有するジグライム可容性シロキサン・イミドコポリマーが得られる。

通常本発明のジグライム可俗性シロキサン -イミドコポリマーは次の一般式 (I)をもつている。



$$\begin{pmatrix}
0 & 0 \\
|| & || \\
C & C \\
N & Ar & N-R \\
C & C \\
|| & || \\
0 & 0
\end{pmatrix}
\xrightarrow{R^1} R^1 \\
\stackrel{|}{|} SiO \\
\stackrel{|}{|} R^1 \\
\stackrel{|}{|} R^1$$

ここで、各 Ar はそれぞれ独立して芳香族基であり、Rは置換もしくは非置換のヒドロカルビレン 基または次式の基である。

$$-Q-Z-R^5-.$$

ただし、Qは置換または非置換の芳香族基であり、 2は

ただし、 R⁴ は炭素原子を/~9個有するアルキル あであり、 R⁵ は炭素原子を/~4個有するアルキレン 基である。 さらに上配一般式(II)中、 Y は酸素またはイオウであり、 a . b . c および n は全て/に等しいかまたはそれより大きい 整数である。

本発明のコポリマーの低いガラス転移温度(約-//0~約0℃が好ましい)を有するブロックは次式(IV)のシロキサン・イミドポリマー単位から得られる。

$$(|Y|) \left\{ \begin{array}{c|c} O & O \\ & & \\ C & C \\ & & \\ N & Ar & N-R \\ & & \\ C & C \\ & || & || \\ O & O \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & R^{1} \\ & \\ SiO \\ & \\ R^{1} \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ SiO \\ & \\ R^{1} \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ SiO \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ \end{array} \right. \left. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ \end{array} \right. \left. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1} & \\ \end{array} \right. \left. \begin{array}{c|c} R^{1$$

さらに、ジオルガノシロキシ単位が存在するため ある程度の柔軟性すなわち可撓性、たとえば低温 での弾性も最終生成物に付与され得る。

このようなポリマーの製造は業界で周知であ

C 0 1 to C

であり、 R⁵ は置換または非置換のヒドロカルビレンである。 また上記一般式(I)中、各 R¹ はそれぞれ独立に選択された置換または非置換のヒドロカルビル基であり、 R² は次のものから成る 群から選択された基である。

り、たとえば米国特許第*3.3.2.5.4.5.0*号および第 *4.3.9.5.5.2.0*号(これらの両者を提用して本明細書 の開示内容に含める)の数示するところに従つて 製造できる。 一般に、二無水物をジアミンと、 特に本発明ではジアミノで末端停止したポリジオ ルガノシロキサンと、反応させてポリアミド酸を 形成し、その後このポリアミド酸を加熱して環化 することによつてポリイミドを製造する。

上記式 (N) 中の Ar は四価のベンゼンもしく はナフタレン核または次式の四価の基であること ができる。

ここで、mは0または/であり、Eは次のものである。

ただしょはノーよの盛欲である。

さらに好ましい堕版では、ジグライムに対する投降生成物の海際性を高めるようなジェーテル結合が式(IV)の Ar に包含される。 すなわち、このさらに好ましい態似では式(IV)の Ar は次式の四価の致基である。

ここでGはフェニレンまたは次式の誌である。

ただしEとmは既化定感したとおりである。

特化好主しい式(N)の Ar は次式を有するものである。

ヘテロ原子はN,OおよびSから沿択される)で あり、Zは

- NC-, - CN-, - C-O-, または-O-C-; であり、 R⁵ は R の 位 田内 に入る ヒドロカルビレン 基である。 R は 低 級 アルキレン 基が 好ましく、プロピレンが 碌も好ましい。 これらの 基とその他の 適当な R 基 は 英界で公知であり、 米国 等 许郎 3325450 号および 節 4395527 号 に さら に 岸 しく に 改されている。

適切な Ar 基と対応する二無水物反応体のさらに完全なリストは米国特许第4395527号に見い出すことができる。

Rは超級または非鉛袋のヒドロカルビレン基のいずれでもよく、たとえば、メチレン、エチレン、プロピレン、イソプロピレン、イソブチレンのように炭公原子を約20個まで有する直鎖もしくは分枝のアルキレン基、骨格質が/個以上のフェニレン基で中断されており炭公原子を約20個まで有するアルキレン基、または次式の基である。

$$-Q-Z-R^5-$$

ここで、Qはフェニレンもしくはナフタレンのような位換もしくは非位換の芳香族ヒドロカルピレン基のいずれかまたは初珠環式芳香族基(ただし、

特性に応じて超当な R¹ 描とその他の苺を、余分な突換をすることなく適当な例合で選択することができる。

上記の式(I)と(N)で、aは/に等しいかまたはそれより大きい任意の盛改であることができ、/O.より大きいと好ましい。 また、nは/より大きい任意の逸改であることができ、よ~約/00が好ましい。

本発明では式(N)で扱わされる前記のポリマー 単位に加えて、次式(V)の有根ポリイミド単位のブロックも少なくとも/つ存在する必要がある。

これによつて、本発明のコポリマーの高いガラス 伝移温度(約100~300℃が兵型であり、150 ~300℃が好ましい)を有するブロックが得られ る。

このような単位によつて最終生成物が熱可塑性を有するようになることは当業者には理解されよう。 したがつて、本発明の新規な組成物は「熱可型性エラストマー」と最も良く扱わすことができる。

式 (V) の Ar は二価の芳香族基のいずれであることもでき、式 (IV)の Ar 基よりは多少狭いのが好ましい。 すなわち、式 (V) の

は、その芳香族基がYを介してフェニル基に二価 結合する必要があるという点で式(IV)の Ar の亜 群と考えることができる。 Yは酸素またはイオ ウ原子であり、酸素原子が好ましい。 式(V)の 適当な Ar 基は当業者が容易に決定できる。

本発明に従つてジグライム可軽性シロキサン - イミドコポリマーを得るのに重大なことは、R²

いのが好ましい。

本発明の特に好ましい態様では式(IV)の構造 単位の有機ポリイミド部分は式(V)の構造単位と 同じである。 こうすると当業者は、式(IV)と (V)の中間体ポリマーを最初に形成する必要なく 一段階で本発明の組成物を共重合することができ る。 たとえば、式(IV)の中間体ポリマーは次式 (A)の二無水物と次式(B)のアミノで末端停止し たシロキサンを反応させて製造し、

(B)
$$NH_2$$
-(CH_2)₅ $\begin{pmatrix} CH_5 \\ i \\ SiO \\ CH_5 \end{pmatrix}$ n CH_2 NH_2 .

が次のものから成る群から選択された基でなけれ ばならないということである。

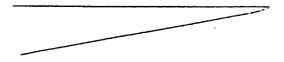
ここで、 R⁴ は炭素原子を1~9個有するアルキル基であり、炭素原子1~3個が好ましく、メチルが最も好ましい。 また R⁵ は炭素原子を1~ メ個有するアルキレン基であり、炭素原子1または2個が好ましく、メチレンが最も好ましい。

式 (V) で b は / に等しいかまたはこれより大きい任意の整数であることができ、 / O より大き

式(V)の中間体ポリマーは

と、たとえば次式

のジアミンとを反応させて製造する。 反応体(A)の Ar が次式を有する場合、



これは反応体(C)と同じである。 反応体(C)と(D)の反応は反応体(A)と(B)の反応に比べて位めて盗いことが判明した。 したがつて、反応体(D)が全部使い尽されるまでは有极ポリアミド殴ブロックのみが形成され、次いで致つている二無水物(すなわちAとC)とアミノシロキサンから設アミド・シロキサンブロックが形成される。

しかし、反応対(A)と(C)が同一でない場合、 プロックコポリマーを得るためにはまず祭界で公 知の方法によつて式(4)と(5)の中間体ポリマーを形成する必要がある。 これらの中間体ポリマーが 形成されたらこれらを互いに直合させて本発明の 組成物を形成する。 本発明のコポリマーの他の 製造方法は当然者には自明であろう。

上述した俎成物は半導体、電子デバイス等の

授用によつて本明細で中に包含する)には、次式 の感光性ポリアミド酸俎成物からホトレジストが 製造できることが開示されている。

ここで、Rは四価の有根基または四価のオルガノシロキサン含有基であり、 R は二価の有根基または二価のオルガノシロキサン含有基であり、 A は感光性のアクリレート、シンナメートまたは 2。3 - ジフェニルシクロプロペノールエステル含有 基である。

たとえば、クレイ(Kray)が蛟界に教示しているように、ポリアミド酸をシリコンウェーハのような基板に盗布し、次にこの基板にマスクを付け、マスクされていない部分に契橋を起こさせるように光頭にさらし、その後契橋したポリアミド

機数コーティングの分野で特に有用であろう。 本発明のコポリマーは単に従来技術の有機ポリイ ミドとシロキサン・イミドの中間のガラス 医移温 度を示し、したがつてそのような従来技術の組成 物の中間の有用な加工 短囲を示すだけであると予 観されるであろうが、全く冷くべきことに、本発 明をなすこのような従来技術のポリイミドの組み 合せでは 2 紅の異なるガラス 医移温度を有すると 考えられる組成物が得られる。 こうして、本発 明によつて、従来技術の数示から予期されるであ ろうよりもずつと広い 温度短囲で有用な新規なコ ポリマーが得られるのである。

本発明の別の一面において、かつ本明拠む中 に開示した組成物のジグライム辞解性の結果とし て、ホトレジストの製造に有用な組成物を関裂す ることが可能である。

/984年/月24日に出願されたW. D. クレイ(Kray)の同時保以中の米国出願番号第 573 883号およびG. ディビス(Davis)の米国出願(これら双方とも本発明の顧受人に酸焼されており、

は形けないが契続していないポリアミド酸は形ける容徴にホトレジストをさらすことによつてמ光した基板を現像し、 登後に現像したホトレジストをポリアミド酸がポリイミドに伝換されるのに充分な温度に加強する。 上述した理由により、ホトレジストの設造に本発明のジケライム可容性組成物を使用することが望ましいであろう。 これは、式(1)の R 基の/個以上にたとえば式

○ □ □ - C - OH の基を結合することによつて容易に造成することができる。 このカルボン改基は、本発明の組成物をイミド化した後、次式の感光性化合物と反応させることができる。

ここで、 R は 以 然 原子 を / ~ 8 値 有 する 二 価 の 基 で あ り 、 B は 感 光 性 の ア ク リレー ト 、 シン ナ メート また は 2、3 - ジ フェニル シ クロ プロ ペ ノ ー ル エステルを 含 有 する 基 で ある。 こ う し て 、 感 光

性ポリアミド酸組成物ではなく感光性ポリイミド組成物が得られ、これは常用の方法によつてシリコンウェーハのような基板に盗布することができ、この盗被基体を所図のパターンが得られるようにマスクで被型した接適当な光証にこの基体を解光し、その後この認光した基体を、適当な쯈យにさらったとによつて現似する。 クレイ (Kray)の場合と同様に契約していない組成物は不辞である。 ほかきと同様に契約していない組成物は不辞である。 な 光性の基が結合している本発明の組成物を使用することの利点は、ホトレジストを高温にさらしてィミド化を起こさせる必要がないことである。

突施例

以下の**突施例で本**発明の**突**施を例示するため に使用したモノマーは次のとおりである。 SDA 3.3'-スルホニルジアニリン

後室温で SDA を *1.248*(0.005 モル)加えた。 改しく 拉拌しながら 室温 で 24 時間 反応を続けた。 可格性ポリアミド 取格液を得た。

突施例 /b

突施例 / a に配成の手履を扱り返した。 ただし、反応体としては無水 NMP 20 叫中のBPADA 5 20 g (20 / モル) と TDA / 22 g (20 / モル) を使用した。 室温で 24 時間反応させて可容性のポリアミド酸を得た。

爽施例 /c

突施例 / a に配徴の手順を扱り返した。 ただし、反応体としては無水 NMP 20 単中のBPADA 260 g (2005 モル)と MDA 299 g (2005 モル)を使用した。 室風で 24 時間反応させて可容性のポリアミド酸を得た。

奥施例 /d

突施例 / a に配改の手限を繰り返した。 ただし、反応体としては無水 NMP 30 W中の BPADA 6248(00/2モル)と ODA 2498 (00/2 モル)を使用した。 室温で 24 時間反

BTDA 3. 3. 4. 4. 4. ベーベンゾフェノンテトラカル ポン酸二無水物

TDA 2.4-トルエンジアニリン

MDA メチレンジアニリン

GAPDS
$$H_2N - (CH_2)_{\frac{1}{2}} \leftarrow \begin{pmatrix} CH_4 \\ SiO \\ CH_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_5 \\ Si \\ CH_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_5 \\ Si \\ CH_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ Si \\ CH_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} CH_2 \\ Si \\ CH_5 \end{pmatrix}$$

ODA オキシジアニリン

BPADA ピスフェノール・A・二無水物

GAPPS-9
$$H_2N$$
-(- CH_2) $\frac{CH_5}{SiO}$ $\frac{CH_5}{SiO}$ $\frac{Si}{CH_5}$ CH_5

PMDA ピロメリト酸二級水物 突施例 /a

/00㎡の丸底フラスコに BPADA を 260 g (0.005モル) および無水 N - メチルピロリドン (NMP) を 25 ㎡入れた。 BPADA を経探した

応させて可容性のポリアミド酸を得た。 突旋例 2a

丸底フラスコにBTDAを&448(QQ2モル) と無水NMPを278入れた。 BTDAが経際した 後路液にTDAを3668(QQ3モル) 室温で加え た。 別のフラスコで、BTDA &448(QQ2モル)を無水NMP 348中でGAPPS-9 8408 (QQ/モル)と反応させた。 これらの2型の唇 液を16時間反応させ、この時点で2つを一緒に し、さらに48時間室温で反応させて均低なポリ アミド酸格液を得た。

突施例 2b

丸底フラスコに PMDA を 5 4 3 8 (0 0 2 モル)、ODA を 4 00 8 (0.02 モル)、 および無水 NMPを 5 5 以入れた。 反応を室温で 2 時間行ない、 この時点で溶液に GAPPS - 9 を 8 4 0 8 (0.0 / モル) 加えた。 反応をさらに 48 時間続けて可容性のポリアミド酸溶液を得た。

突施例 3a

100 Wの丸底フラスコに BPADA を 2.28 g

(*001*4 モル)、GAPDS を 3488 (*001*4 モル)、および無水 NMP を 30 × 入れた。 反応を 室温で 24 時間実施してポリアミド酸母液を得た。 実施例 3 b

/00 配の丸底フラスコに BPADA を 2.80 g (Q O / S モル)、 TDA を 1.22 g (Q O / モル)、 および無水 NMP を 40 配入れた。 室温で 3 分間 欲しく投拌した後、 GAPPS - 9 を 4.20 g (Q O O S モル) 加えた。 反応を 24 時間続けて可容性の ポリアミド酸容液を得た。

実施例 3c

/00 配の丸底フラスコに BPADA を / Q.48 (Q.02 モル)、 GAPPS - 9 を / 2.648 (Q.02/ モル)、および NMP を 60 配入れた。 別のフラ スコで、 BPADA 《688 (Q.009 モル)と MDA / 5868 (Q.008 モル)を無水 NMP 20 配 に加 えた。 次に、これら 2種の薔薇を室弧で 24 時間反応させ、この時点でこれらを一緒にし、さら に 48 時間室温で反応させてポリアミド酸薔薇を 得た。

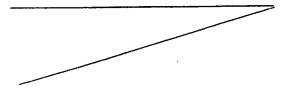
さらに 48 時間反応させた。

実施例 5

上配の溶液を 0.070× 4× 4 インチのテフロン(Teflon®) 製金型内に注ぎ、強制空気流オーブン中約 /25℃で 20 時間、その後別の強制空気流オーブン中約 250℃で 45 分間加熱することによってイミド化を実施した。 20 インチ/分のクロスヘッド速度を用いる標準法によって各サンプルの引張強さをテストした。 結果を要 [に示す。

実施例 6

次に、引張強さの例定に使用した注形フィルムの小片をよ~ 20 倍の重量のジグライム中に入れ、90℃で約/5分加熱した。 このジグライム 密解性テストの結果も表しに示す。



爽施例 3d

/00 配の丸底フラスコに BPADAを /6/2 g(003/モル)、メチルエチルケトン (MEK) 80 g中の ODA を 60 g(003モル)、および無水 NMP を 35 g入れた。 もう / つの / 00 配の丸底フラスコに BPADAを / 04 g(002モル)、MEK 40 g中の GAPDS を 497 g(002/モル)、および無水 NMP を / 5 配入れた。 4 時間の反応後これら 2種の溶液を互いに混合し、次いでさらに / 6 時間反応を続けて均質なポリアミド酸溶液を発た。

突施例 ¥a

/00 配の丸底フラスコに BPADA を / 0.4 8
(0.0.2 モル)、GAPPS - 9を / 7.6 4 8 (0.0.2 / モル)、および無水 NMP を 60 配入れた。 別の
/00 配の丸底フラスコに BTDA を 4 / 8 8 8 (
0.0 / 3 モル)、TDA を / 4 6 6 8 (0.0 / 2 モル)、
および無水 NMP を 25 配入れた。 これらの密放を各々 24 時間反応させ、この時点でこれらを互いに混合し、可容性のポリアミド酸を得るように

裘 [

<u>~</u>			
実施例	ブロック構造	ジグライム 溶解性	引張強さ(psi)
/ a	(BPADA - SDA)	なし	能すぎてテスト できない
/ b	(BPADA - TDA)	なし	3500
/ c	(BPADA-MOA)	なし	施士ぎてテスト できない
/ d	(BPADA - ODA)	なし	胎すぎてテスト できない
.2 a	((BTDA - TOA) ² (BTDA - GAPPS -9))	なし	4700
2 b	((PMDA - TOA) ² (PMDA - GAPPS -9))	なし	脆すぎてテスト できない
<i>3</i> a	BPADA - GAPDS	あり	5350
<i>3</i> b	((BPADA-TDA)2 (BPADA-GAPPS -9))	あり	4600
<i>3</i> c	(BPADA-MDA) (BPADA-GAPPS -9)20)	あり	3500
<i>3</i> d	((BPADA-ODA) 50 (BPADA-GAPPS	あり	6/00

これらの結果が示しているのは、本明細 中に開示した数示を実施したときにだけ、低ガラス 転移温度のポリマーブロックを少なくとも/つと 高ガラス転移温度のポリマーブロックを少なくと も/つを有するジグライムに可器なポリイミドが 得られるということである。

> 特許出版人ゼネラル·エレクトリック·カンパニイ 代理人 (7830) 生 沼 復 二